

1 電荷保存則

問 1-1. 図 1 のように、断面積 S [m²] が一定の導線を x 軸に沿って置き、
 一様な密度 j [A/m²] の電流を流した。微小体積領域 $[x, x + \Delta x]$
 における電荷 (密度 ρ [C/m³]) のつりあいから、電荷保存則を導け。

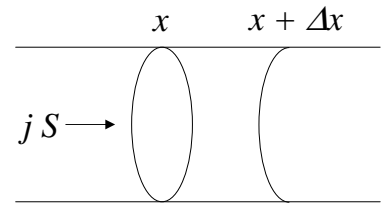


図 1: 断面積一定の導線を流れる電流

問 1-2. 電荷保存則の物理的意味を述べよ。

問 1-3. 電荷保存則と同様の他の保存則を例示し、 ρ と j に対応する物理量を示せ。

2 電磁波の反射と屈折

図 2 のように、電磁氣的性質の異なる媒質 1 (誘電率 ϵ_1 , 透磁率 μ_1) と媒質 2 (ϵ_2, μ_2) が接している境界 (xy 平面) に、電磁波が入射すると、反射や屈折が起こる。以下では、媒質内や境界において、電荷も電流も存在しない ($\rho = 0, j = 0$) とせよ。

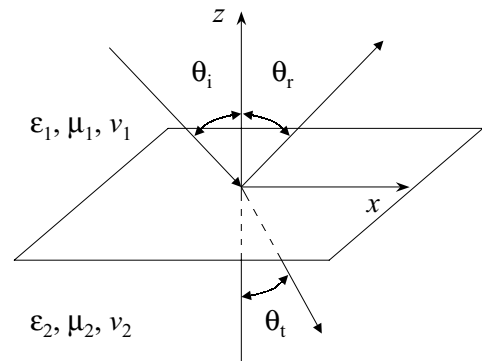


図 2: 境界面における電磁波の反射と屈折

問 2-1. 電磁誘導の式 ($\text{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$) とストークスの定理
 $(\int_S \text{rot} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s})$ を使い、境界条件 $E_{1t} = E_{2t}$
 を導け。ここで、 E_{1t} と E_{2t} は、境界面における媒質 1
 と媒質 2 の電場の接線成分である。

アンペール・マクスウェルの式で同様の計算をすると、磁場のみたすべき条件は $H_{1t} = H_{2t}$ になる。

問 2-2. 電場ベクトルを $\mathbf{E}_j = E_{j0} \exp i(\omega t - \mathbf{k}_j \cdot \mathbf{x})$, ($j = i$ (入射), t (透過), r (反射)) と表し、波の位相に境界条件
 を適用し、スネルの法則 (θ_r と θ_i, θ_t と θ_i の関係) を導け。ここで、振幅 E_{j0} は定ベクトル、入射波の波数
 ベクトルは $\mathbf{k}_i = (k_{ix}, 0, k_{iz})$ である。また、媒質 1 に対する媒質 2 の相対屈折率を n_{21} とせよ。

問 2-3. 入射波の電場が、入射面 (zx 平面) に対し $\mathbf{E}_{i0} = (0, E_{i0}, 0)$ のように偏っている。電場に対する境界条件
 より、透過波 $\mathbf{E}_{t0} = (E_{tx}, E_{ty}, E_{tz})$ と反射波 $\mathbf{E}_{r0} = (E_{rx}, E_{ry}, E_{rz})$ の各成分と、入射波の振幅成分 E_{i0} と
 の関係を求めよ。

問 2-4. 電磁誘導の式より、磁場は、 $\mathbf{H}_j = \frac{\mathbf{k}_j \times \mathbf{E}_j}{\omega \mu}$ と表される。これを利用し、入射波の磁場の振幅ベクトル
 \mathbf{H}_{i0} を、 $E_{i0}, \omega, \mu_1, k_{ix}, k_{iz}$ を使って表せ。

問 2-5. 問 2-4 と同様に $\mathbf{H}_{t0}, \mathbf{H}_{r0}$ を求め、磁場に対する境界条件を、 E_{i0} などを使って表せ。

問 2-6. 問 2-3 と問 2-5 で求めた式を連立させて、反射波と透過波の電場の振幅を求めよ。ただし、透磁率は $\mu_1 = \mu_2$
 の関係をみたとし、結果は $E_{i0}, n_{21}, \cos \theta_i, \cos \theta_t$ のみを使って答えよ。

問 2-7. 入射波、反射波および透過波のポインティングベクトル $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ を求め、入射波のエネルギーの流れが、反
 射波と透過波のエネルギーの流れの和に等しいこと、つまり、エネルギーが保存されることを示せ。